

描述 / Descriptions

TO-252 塑封封装 N 沟道 MOS 场效应管。N-CHANNEL MOSFET in a TO-252 Plastic Package.

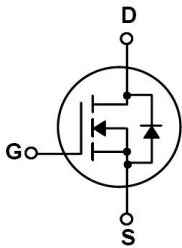
特征 / Features

低栅电荷,低反馈电容,开关速度快。
Low gate charge, low crss, fast switching.

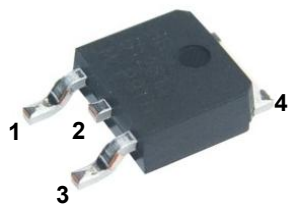
用途 / Applications

该器件适用于适配器和充电器的功率开关电路
These devices are well suited for power switch circuit of adaptor and charger.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : G PIN 2 : D PIN 3 : S PIN 4 : D

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。 See Marking Instructions.

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Drain-Source Voltage	V_{DS}	700	V
Drain Current	$I_D(T_c=25^\circ\text{C})$	4.0	A
Drain Current	$I_D(T_c=100^\circ\text{C})$	3.2	A
Drain Current - Pulsed	$I_{DM}^{①}$	16	A
Gate-Source Voltage	V_{GS}	±30	V
Single Pulsed Avalanche Energy	$E_{AS}^{②}$	150	mJ
Power Dissipation	P_D	70	W
Junction Temperature Range	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	°C
Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.79	°C/W
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Drain-Source Breakdown Voltage	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V$ $I_D=250\mu A$	700			V
Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS} / \Delta T_j$	$I_D=250\mu A$ Referenced to 25°C		0.6		V/°C
Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}$ $I_D=250\mu A$	2.0		4.0	V
Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=700V$ $V_{GS}=0V$ $T_j=25^\circ\text{C}$			10	μA
		$V_{DS}=560V$ $V_{GS}=0V$ $T_j=125^\circ\text{C}$			100	μA
Forward Transconductance	g_{FS}	$V_{DS}=15V$ $I_D=2.0A^{③}$		3.5		S
Gate-Body Leakage Current Forward	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V$			±10	uA
Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V$ $I_D=2.0A^{③}$		2.5	2.8	Ω
Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS}=0V$ $V_{DS}=25V$ $V_F=1.0MHz$		520		pF
Turn-Off Delay Time	$t_{d(off)}$	$V_{DD}=350V$ $I_D=4.0A$ $R_G=25\Omega^{③}$		45		ns

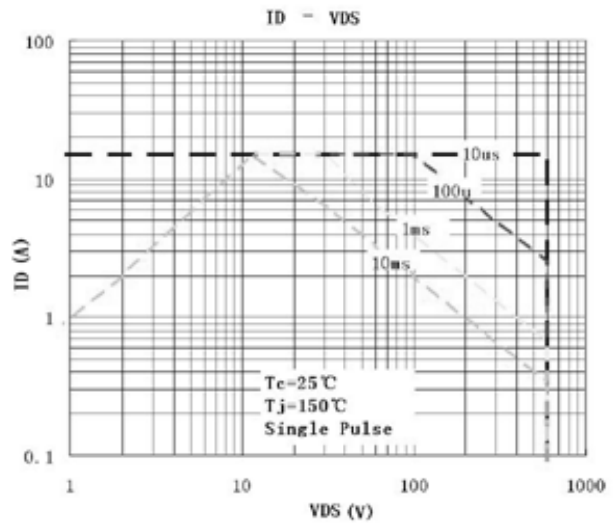
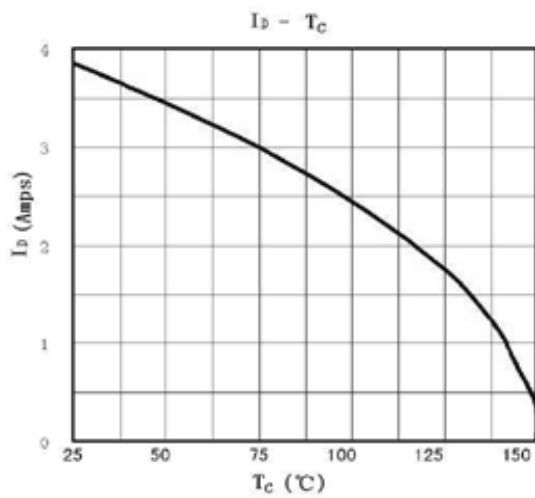
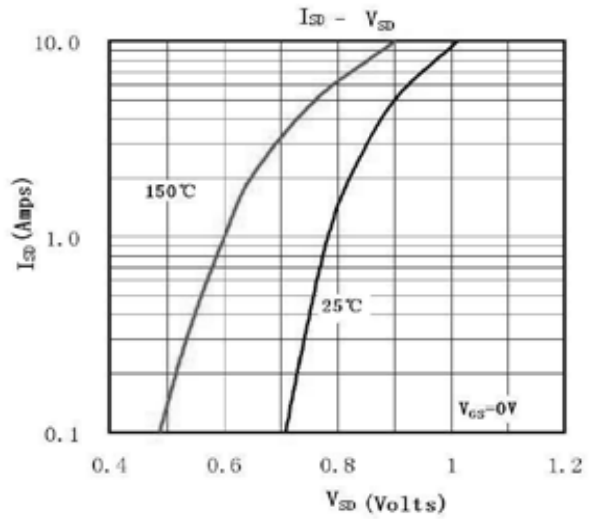
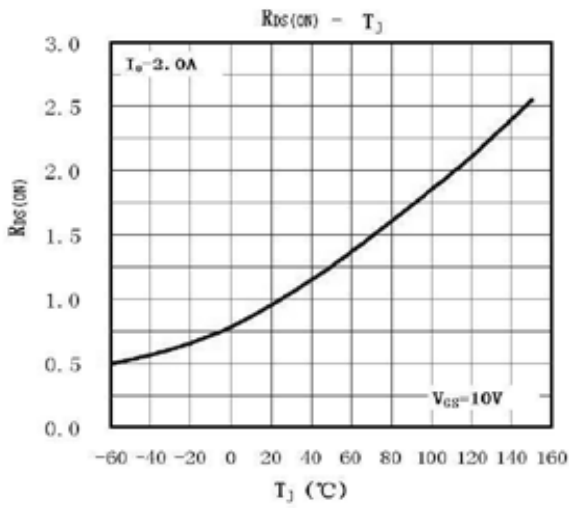
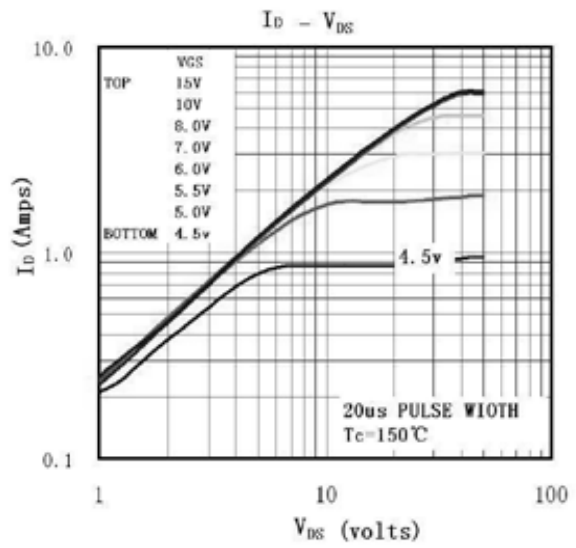
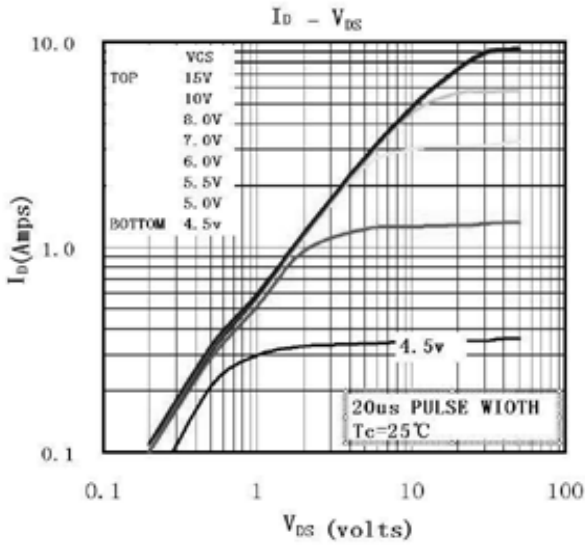
电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Total Gate Charge	Q_g	$I_D=4.0A$ $V_{DS}=350V$ $V_{GS}=10V^{③}$		15		nC
Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			3		nC
Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			6		nC
Continuous Diode Forward Current	I_S				4.0	A
Diode Forward Voltage	V_{SD}	$I_S=4.0A$ $V_{GS}=0V^{③}$ $T_j=25^\circ C$			1.4	V
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_f=4.0A$ $T_j=25^\circ C$ $di/dt=100A/\mu s^{③}$		198		nS
Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			770		uC

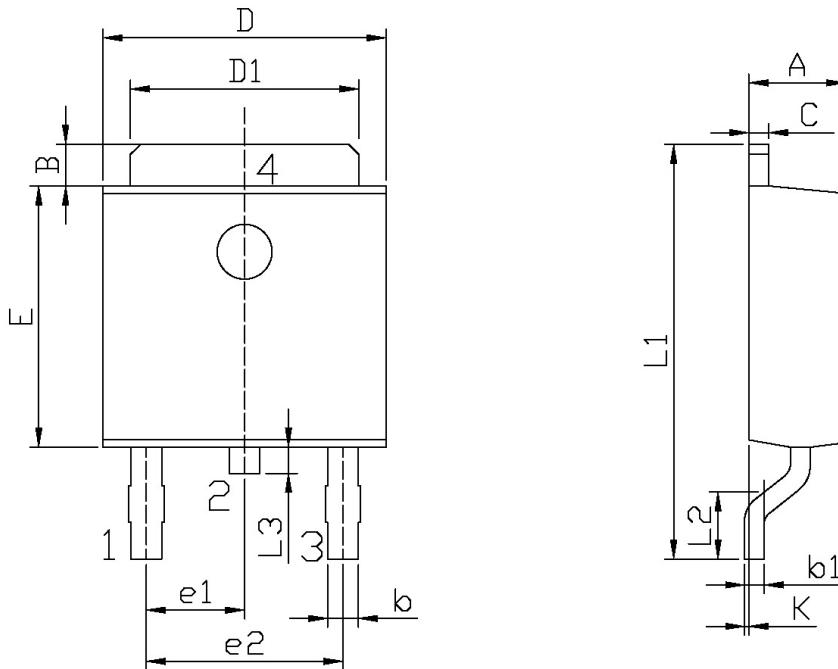
注释(Notes):

- ① : 脉冲宽度 : 以最高结温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② : 初始结温=25°C, $V_{DD}=50V$, $L=30mH$, $R_G=25\Omega$, $I_{AS}=4.0A$
Starting $T_j=25^\circ C$, $V_{DD}=50V$, $L=30mH$, $R_G=25\Omega$, $I_{AS}=4.0A$
- ③ : 脉冲测试 : 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test: Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



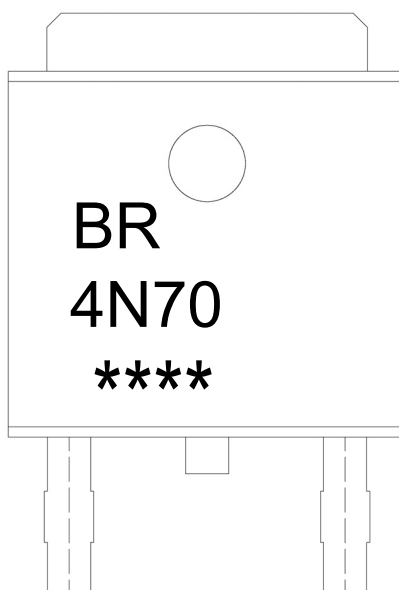
外形尺寸图 / Package Dimensions



单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	2.20	2.40	E	5.95	6.25
B	0.95	1.25	e1	2.24	2.34
b	0.50	0.70	e2	4.43	4.73
b1	0.45	0.55	L1	9.45	9.95
C	0.45	0.55	L2	1.25	1.75
D	6.45	6.75	L3	0.60	0.90
D1	5.10	5.50	K	0.00	0.10

TO-252



说明：

BR： 为公司代码

4N70： 为型号代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

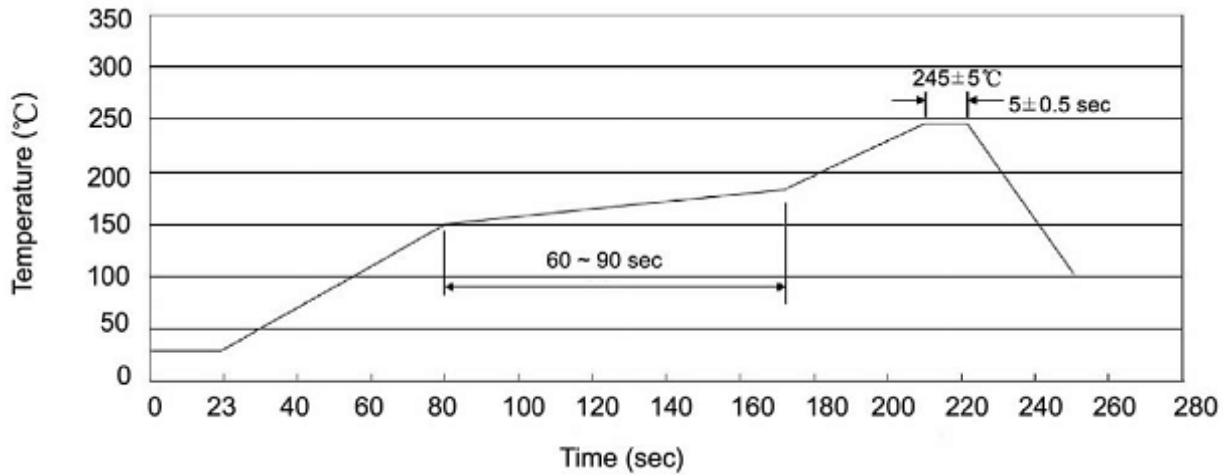
BR: Company Code

4N70: Product Type.

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

BRD4N70

Rev.E May.-2016

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)


说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	5	25,000	13" ×16	360×360×50	385×257×392

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [MOSFET](#) category:

Click to view products by [Blue Rocket](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [NTNS3A92PZT5G](#) [IRFD120](#) [IRFF430](#) [JANTX2N5237](#) [2N7000](#) [2SK2464-TL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [2SJ277-DL-E](#) [2SK2267\(Q\)](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [MIC4420CM-TR](#) [VN1206L](#) [614234A](#) [715780A](#)
[SSM6J414TU,LF\(T](#) [751625C](#) [PSMN4R2-30MLD](#) [TK31J60W5,S1VQ\(O](#) [2SK2614\(TE16L1,Q\)](#) [DMN1017UCP3-7](#) [EFC2J004NUZTDG](#)
[FCAB21350L1](#) [P85W28HP2F-7071](#) [DMN1053UCP4-7](#) [NTE2384](#) [NTE2969](#) [NTE6400A](#) [DMN61D9UWQ-13](#) [US6M2GTR](#) [DMN31D5UDJ-7](#) [SSM6P54TU,LF](#) [DMP22D4UFO-7B](#) [IPS60R3K4CEAKMA1](#) [DMN1006UCA6-7](#) [DMN16M9UCA6-7](#) [STF5N65M6](#) [STU5N65M6](#)
[C3M0021120D](#) [DMN13M9UCA6-7](#) [BSS340NWH6327XTSA1](#) [MCM3400A-TP](#) [DMTH10H4M6SPS-13](#) [IPS60R1K0PFD7SAKMA1](#)
[IPS60R360PFD7SAKMA1](#)